

specificazioni	
Modello di prodotti	RFN1L6STE25
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	DIODE GEN PURP 600V 800MA PMDS
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori-
Stato parte	947 pcs Stock
Tensione - diretta (Vf) (max) a If	1.45V @ 800mA
Tensione - inversa (Vr) (max)	600V
Contenitore dispositivo fornitore	PMDS
Velocità	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Tempo di ripristino inverso (trr)	35ns
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucri	DO-214AC, SMA
Temperatura di funzionamento - Giunzione	150°C (Max)
Tipo montaggio	Surface Mount
Tipo diodo	Standard
Corrente - Dispersione inversa a Vr	1µA @ 600V
Corrente - raddrizzata media (Io)	800mA
Capacità a Vr, F	-

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RFN1L7SFJ TE25 ROHM RFN1L7SFJ TE25 ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RFN1L6S ROHM RFN1L6S ROHM	 RFN1L7STE25 Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 700V 800MA PMDS	 RFN1L7SDD ROHM RFN1L7SDD ROHM
 RFN1L7S ROHM RFN1L7S ROHM	 RFN12TJ6S ROHM ROHM TO220	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RFN1L7S TE25 ROHM RFN1L7S TE25 ROHM	 RFN1L6SDD ROHM RFN1L6SDD ROHM

Di Più